

(11)Publication number:

03-103760

(43)Date of publication of application: 30.04.1991

(51)Int.CI.

G01N 27/12

(21)Application number : 01-241561

(71)Applicant: NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

18.09.1989

(72)Inventor: MATSUURA TOSHITAKA

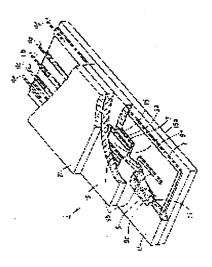
KUROKI YOSHIAKI TAKAHASHI KOICHI MIZUMOTO KATSUYOSHI

(54) GAS DETECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the deterioration of a thermistor for making the temp. compensation of a gas sensitive element so that the temp. compensation of the gas sensitive element can be exactly executed by forming the above- mentioned thermistor in a hermetic chamber having a cavity.

CONSTITUTION: An oxygen n sensor 1 is formed with the gas sensitive element 5, an ion conductive thermistor 7, etc., on a ceramic substrate 3 and is laminated with a ceramics laminated plate laminated with apertures 13, 15 respectively in the corresponding positions of the element 5 and the thermistor 7. The cavity 15a is formed in the upper part of this aperture 15 and the thermistor 7 is formed in the hermetic chamber having the cavity 15a. The change in the gas detecting characteristic arising from a temp. change of the element 5 can be compensated by the result of the detection of the element temp. by the thermistor 7 so that the gas to be detected and the concn. thereof can



be exactly detected. Since the thermistor 7 is provided in the hermetic chamber, the deterioration in the temp. detection characteristics by the harmful materials in the outdoor air is obviated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY

[Number of appeal against exper's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-103760

fint, Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月30日

G 01 N 27/12

В 9014-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

❷発明の名称 ガス検知器

> ②特 顆 平1-241561

平1(1989)9月18日 ②出

@発 明 者 松 浦 利 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式 会社内 @発 眲 黒 木 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式 @発 明 老 髙 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 浩 日本特殊陶業株式 会社内 個発 明 元 克 芳 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式 会社内

①出 顧 日本特殊陶業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

四代 理 人 弁理士 足 立

1 発明の名称

ガス検知器

2 特許請求の範囲

酸化物半導体からなり周囲雰囲気中のガス成分 に応じて電気抵抗が変化する感ガス素子と、 該感 ガス素子の温度を検出するイオン伝導性のサーミ スタと、を備えたガス検出器において。

上記サーミスタを、 空洞を有する密室に形成し てなることを特徴とするガス検知器。

3 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はチタニア等の酸化物半導体を用いて周 囲雰囲気中のガスを検知するガス検知器に関する。 [従来の技術]

この種のガス検知器は 酸化物半導体の抵抗値 が周囲雰囲気中のガス成分によって変化すること を利用してガスを検知するものであるが、 酸化物 半導体は ガス成分の他に 温度によっても抵抗 値が変化するため、 こうした酸化物半導体の湿度 依存性を何等かの方法で補償する必要がある。

このため従来より、 この種のガス検知器では、 (1) 感ガス素子(即ち、酸化物半導体)を加熱す るヒータを設け、ヒータの発熱量を制御して感ガ ス素子の温度を一定にするとか

(1) 感ガス素子の温度を検出するサーミスタを設 け、サーミスタを用いて感ガス案子の温度補償を 行なう。

といったことが考えられている

[発明が解決しようとする課題]

ところで上記(2) のガス検知器において、サー ミスタにイオン伝導性のものを用いる場合、従来 . では. サーミスタを直接外気に晒して使用してい るため サーミスタが外気中の有害物質により被 毒し、 感ガス素子の温度補償を良好に行えなくな ることがあった。

即ち、 例えばジルコニアを用いたイオン伝導性 のサーミスタでは 第6図に示す如く、電圧を印 加すると、周囲雰囲気中の酸素口。がサーミスタ の負種(一)側で酸素イオン○₂⁻となって正極(

十) 側に移動し、正極(十) 側で再び酸素の。と なることにより、負極(一)側から正極(十)側 に電子を渡し、これによって電流しが流れ、その 電流しの流れ易さ(即ち電気抵抗)が周囲温度に よって変化することを利用して周囲温度を検出す るため、こうしたイオン伝導性のサーミスタを用 いて温度検出を行なうには、サーミスタの周囲に イオン交換用のガスが存在する必要がある。 そこ でこうしたイオン伝導性のサーミスタを用いて感 ガス素子の温度補償を行なう従来のガス検知器で は、サーミスタを作動させるためにサーミスタゼ 外気に直接晒しているのであるが、この場合サー ミスタが外気中の有害物質により被毒し易く。 ガ ス検知器を長時間使用しているうちに、 温度検出 特性が劣化して、感ガス素子の温度補償を良好に 行えなくなってしまう。

そこで本発明は、イオン伝導性のサーミスタを 用いて感ガス素子の温度補償を行なうガス検知器 において、サーミスタの劣化を防止して感ガス素 子の温度補償を常に正確に行えるようにすること

値)により捕債することが可能となり、 彼検知ガ ス及びその濃度を正確に検知できるようになる。

一方サーミスタは、空洞を有する密定に設けられているため、空洞内のガスにより動作可能で、感ガス素子の温度を検出できる。またサーミスタは、外気に晒されないので、外気中の有害物質によって被毒し、温度検出特性が劣化することもない。このためサーミスタにより、感ガス素子の温度補償を長期間正確に行うことができる。

ここで感ガス素子を形成する酸化物半導体としては、従来より種々のガス検知器に使用されている TiO2、 SnO2、 CoO、 ZnO、 Nb2O6、 Cr2O、 等が挙げられ、 本発明においてもこれらのうちのいずれか 1 つまたは 2 つ以上の組合せの物質を用いることが好ましい。

またイオン伝導性のサーミスタとしては、従来よりZrO2、Al2O3、MlO 等を主成分としたものが知られており、本発明においてもこうした 従来より使用されているものを用いればよい

[実施例]

を目的としてなされた

[課題を解決するための手段]

即ち上記目的を達するためになされた本発明は 酸化物半導体からなり周囲雰囲気中のガス成分 に応じて電気抵抗が変化する感ガス素子と、 該感 ガス素子の温度を検出するイオン伝導性のサーミ スタと、 を備えたガス検出器において、

上記サーミスタを、空洞を有する密室に形成してなることを特徴とするガス検知器を要旨としている。

[作用]

このように構成された本発明のガス換知器においては、感ガス素子が周囲雰囲気中に存在する被検知ガスに接触すると、そのガス濃度に応じて素子の抵抗値は、感ガス累子の温度によっても変化するが、その素子温度はイオン伝導性のサーミスタにより検出されるため、感ガス素子の温度変化に伴うガス検知特性の変化は、サーミスタに払る素子温度の検出結果(具体的にはサーミスタの抵抗

以下、本発明の実施例を図面に基づき説明する。 尚本発明は以下に説明する実施例に限定されるも のではなく、 その要旨を逸脱しない範囲の種々の 態様のものが含まれる。

まず第1図は、感ガス素子としてチタニアを主成分とする酸化物半導体を使用し、内燃機関等。 各種燃烧機器の排気中の酸素濃度を検出する実施・例の酸素センサ1を表す一部破断斜視図である。

はセラミック積層板17より薄く、 開口15の下方に配設されているため、 開口15の上部には空洞15aが形成されている。 また開口15から感ガス素子5とは反対側(白金リード線11a~11e側)のセラミック積層板17上には、セラミック積層板19が積層されており、 これによってサーミスタ7は空洞15aを有する密定に形成されることとなる。 またセラミック積層板19の上部には、補強用のセラミック積層板21が積層されている。

次に上記酸素センサ1は 第2図に示す如き手順に従って作成される。

① まず第2図(a)に示す如く、セラミック 基板3となるグリーンシートを作成し、その表面 の所定の位置にイオン伝導性材料(本実施例では ジルコニア)からなるペーストを印刷することに よりサーミスタ7を形成する。

尚本実施例では グリーンシートを、アルミナ 9 2 wt %、マグネシア 3 wt %、および焼結助剤(シリカ、カルシア等) 5 wt % をポットミルにて 2

るといった手順で作成した

③ そしてこのようにセラミック基板3上に意 ·極パターンが形成されると、第2図(c)及びそ のA-A線断面図を表す (C-I) に示す如く、 セ ラミック基板3と同様の大きさで、 サーミスタフ 位置及び感ガス素子 5 を形成する所定の位置に失 々関ロ 1 5、 1 3 を有するグリーンシートを、上 配①のグリーンシートと同様の手順で作成し、 こ れをセラミック積層板17として、 上記②で各種 電極パターンを印刷したセラミック基板 3 の表面 に積層熱圧着する。 尚このとき電極パターン 9 a ~9cの一端及び発熱抵抗電極パターン9dの両 端には 白金リード線11a~11eを設け、白 金リード線11a~118を両グリーンシート間 に固定する。またこの積層によって、 関口 13内 では電極パターン9b及び9cの先端が露出し、 開口15内ではサーミスタ7上に印刷された電極 パターン9a及び9bが露出している。

④ 次に第2図(d)及びそのAーA線断面図を要す(d-i)に示す如く、開口13を除くセラ

② このようにセラミック基板 3 上にサーミスタ 7 が形成されると、今度は第 2 図(b)に示す如く、そのグリーンシート上に白金ペーストを印刷することにより、電極パターン9a~9c及び発熱抵抗電極パターン9dを形成する。尚白金ペーストは、白金黒とスポンジ状白金とを 2: 1の比率に調合し、他に上記①で用いたグリーンシートの材料混合物を 1 0 *1%添加し、ブチルカルピドール、エトセル等の溶剤を加えてペースト化す

ミック積層板17上に、上記グリーンシートと同様に作成したグリーンシートを積層熱圧着して、 セラミック積層板19を形成し、更にその上から 上記と同様に作成したグリーンシートを積層熱圧 着して、補強用のセラミック積層板21を形成する

⑤ このようにサーミスタフ及び各種電極パターン9a~9dを内蔵したセラミック積層体が作成されると、今度はこれを大気とほぼ同一雰囲気中にて1550℃で2時間焼成し、セラミック焼鉄体を作成する。

⑥ そしてその後第2図(e)及びそのA-A 線断面図を表す(e-1)に示す如く、 閉口13内にチタニアを主成分とする酸化物半導体のペーストを充填し、今度はこれを1100℃で1時間焼成することにより感ガス素子5を形成する。 尚にのあることにより感がス素子5を形成する。 尚にのあることにより感が、大気中1200℃で1時間で、焼した平均粒径1、2μmのチタニア物末90重量部に対して、触媒として白金黒10重量部を加

え さらに パインダーとして、3 重量%のエチルセルロースを2 重量部だけ添加し、これらをブチカルピトール(2 ー (2 ー ブトキシエトキシ)エタノールの商品名)中で混合することにより、300ポイズの粘度にペースト化するといった手順で作成した

このように本実施例では、セラミックシートの 積層技術を用いて、サーミスタ7を空洞15aを 有する密室内に形成しているのであるが、本実施 例において、サーミスタ7をジルコニアを主成分 とするイオン伝導性材料により形成した第1の理 由は、本実施例ではセラミック基板3及びセラミック積層体17、19、21にアルミナを使用し ており、これら各部と同時焼成が可能となるため である。

また第2の理由は、感ガス素子5にチタニアを使用しており、温度依存性がほぼ等しくなって、感ガス素子5の温度補償を簡単に、しかも正確に行なうことができるためである。 つまり感ガス素子5とサーミスタ7との温度依存性が異なるよう

ており、 発熱抵抗電極パターン9 d の白金リード線11 d にはパッテリ B の負極が接続され、 白金リード線11 e にはパッテリ B の正極が接続され ている。 これは発熱抵抗電極パターン9 d を通常することにより、 発熱抵抗電極パターン9 d を発熱させ、これによって感ガス素子 5 を酸素濃度を検出可能な活性温度以上に速やかに上昇させるためである。

また次に本実施例では、サーミスタフの上に電性パターン9a、9bを形成することで、電極パターン9a、9bが空洞15a側に配設されるで、うにしているが、これはサーミスタフにおおいてきるの吸入・排出は、電性が印加される電極ので行われるため、電性が1のでである。では、1000で行われるため、電性が100ででは、100でである。では、100でで

な場合には 感ガス素子 5 及びサーミスタフを個 々に作動させて、 被測定ガスのガス 濃度と素子温 度とを失々検出し、その後、検出したガス濃度を 素子温度で補正することにより温度補償されたガ ス濃度が得られるようになるのであるが、 本実施 例では、サーミスタフに感ガス素子5と同じ温度 依存性のものを使用しているので、 例えば第3図 に示す如く、電極パターン9cを介して感ガス素 子5に接続される白金リード線11cをパッテリ Bの正極に接続すると共に、電極パターン9 a を 介してサーミスタフに接続される白金リード線1 1 a をパッテリの負種に接続し、その時、電極パ ターン9bを介して感ガス素子5及びサーミスタ 7 に接続される各部の共通電極となる自会リード 線11bと白金リード線11aとの間に生ずる電 圧 V を検出することにより、 湿度補償された感ガ ス素子5の抵抗値 即ちガス濃度を簡単に知るこ とができるようになるのである。

一尚第3図は、本実施例の酸素センサーを使用して酸素濃度を検出する際の検出回路の一例を表し

が、 本実施例のように電極パターン 9 a. 9 b をサーミスタ 7 上部の空洞 1 5 a 側に設ければ、 その境界面に酸素の吸入・排出を行うための対策を施す必要がなくなるのである。

第5図に示す如く、サーミスタ7を密閉蓋52 により密閉した酸素センサ54(試料S3)では 空洞がなく、サーミスタ 7 が酸素の吸入・抑力できないため、所謂プラックを表することができないため、所謂の変し、素子温度を検出することはできないサ 5 0 (成分を出することはできないサ 5 0 (成分を設定した過度の検出に対した。 大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、カーミスタ 7 を空洞したは、大きのでは、カーミスタ 7 の抵抗値は発き、このには、サーミスタ 7 の抵抗値は発き、1)では、サーミスタ 7 の抵抗値は発き、1)では、サーミスタ 7 の抵抗値は発き、1)には、サーミスタ 7 の抵抗値は発き、1)には、サーミスタ 7 の抵抗値は発き、1)には、サーミスタ 7 の抵抗値は発き、1)には、サーミスタ 7 の抵抗値は発き、1

以上説明したように、本実施例の酸素センサーでは、感ガス素子5の温度補償を行なうためのイオン伝導性のサーミスタ7を、空洞15 a を有する密室に形成しているので、サーミスタ7を正常に動作させることができると共に、サーミスタ7が外気により被塞して温度検出特性が低下するのを防止できる。

また本実施例では サーミスタフの電極を空洞

種に接続されるので、セラミック基板3上で電極パターンにより予め接続しておくようにしてもよい。同様に発熱抵抗電極パターン9dの他端に接続される白金リード線11e及び感ガス素子5の電極パターン9cに接続される白金リード線11cは、共にパッテリBの正極に接続されるので、セラミック基板3上で電極パターンにより予め接続しておくようにしてもよい。尚この場合、センサ本体にはリード線を3本設けるだけでよく、センサと検出回路との接続が簡単となる

また第3図の検出回路では、バッテリBを発熱抵抗電極パターン9dと感ガス家子5との共通電源としてしているが、これら各部の電源を個々に設けるようにしてもよい。そしてこの場合には感ガス素子5が発熱抵抗電極パターン9d 倒からノイズ等の影響を受けることがなく、 検出精度をより向上することが可能となる。

「発明の効果」

以上詳述したように本発明のガス検知器においては、感ガス素子の温度補償を行なうためのサー

15 a 側に形成しているので、 サーミスタフで酸素の吸入・排出がスムーズに行なわれ、 酸素の吸入・排出のために孔を設ける等の特別な対策を施す必要がない。

ここで上記実施例では、感ガス案子 5 をセンサ本体からそのまま露出させているが、感ガス案子 5 を鉛等の有害物質から保護するために、その表面に保護層を形成するようにしてもよい、尚この保護層の材質としては熱的に安定な材質であればよく、例えばアルミナ、ジルコニア等を用いることができる。

また上記実施例では、感ガス素子加熱用の発熱抵抗電極パターン9d を、セラミック基板3の感ガス素子5と同一面に形成したが、感ガス素子5と対向する裏面に形成してもよい

また更に上記実施例の酸素センサを第3図の検出回路によって使用する際には、発熱抵抗電極パターン9 dの一端に接続される白金リード線11 d及びサーミスタ7の電極パターン9 aに接続される白金リード線11 aは、井にパッテリBの自

ミスタを、空洞を有する密室に形成しているため、サーミスタを正常に動作させることができると共に、サーミスタが外気により被奪して温度検出特性が低下するのを防止できる。このため本発明のガス検知器によれば、サーミスタの耐久性が著しく向上し、感ガス素子の温度補償を長時間正確に行うことができるようになる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明が適用された実施例の酸素センサを表す一部判断斜視図 第2図はその酸素センサの製造工程図 第3図はその酸素センサを使用して酸素濃度を検出する検出回路の一例を表す電気回路図 第4図は実施例の酸素センサの構成をで耐久試験を行う試料とした酸素センサの構成を表す構成図 第5図はその耐久試験の結果を表す線図 第6図はイオン伝導性サーミスタの動作説明図 である

1 … 酸 寮 セ シ サ 3 … セ ラ ミ ッ ク 基 板

5 … 感 ガス 楽子 7 … サーミスタ

9 a ~ 9 c …電極パターン

BEST AVAILABLE COPY

待開平3-103760(6)

9d…発熱抵抗電極パターン

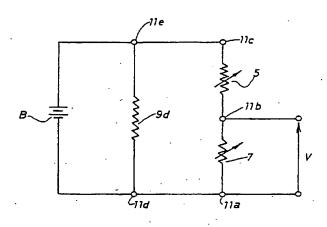
ししゅ~ししゅ…白金リード線

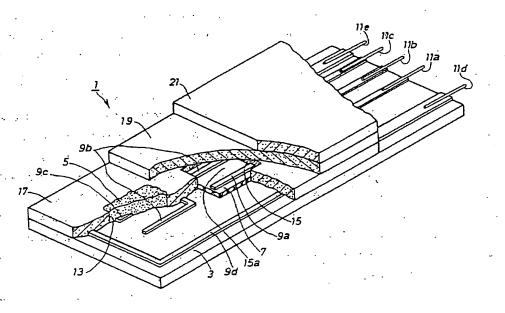
13, 15…開口 15 a…空洞。

17, 19, 21…セラミック積層板・ .

代理人 弁理士 足立 勉

第3図





BEST AVAILABLE COPY



特開平3-103760(プ)

